PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-325313

(43) Date of publication of application: 26.11.1999

(51)Int.CI.

F16K 49/00 F16K 3/16 F16K 3/18 // C23C 16/44 H01L 21/205

(21)Application number: 10-375581

(71)Applicant: BENKAN CORP

(22)Date of filing:

17.12.1998

(72)Inventor: [WABUCHI TOSHIAKI

(30)Priority

Priority number: 08 37471

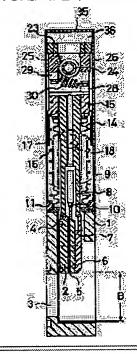
Priority date: 31.01.1996

Priority country: JP

(54) NON-SLIDING GATE VALVE FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate cleaning for a gate and replacement of an O-ring by heating the gate with a gate heater and by separating the gate from the gate heater. SOLUTION: A gate heater for heating a gate 2 stores a sheathed heater 9 on a surface side of a hot plate 6, and a seal plate 5 is provided on the surface side of the hot plate 6 under a sealed condition of the heater 9. A connector 7 mounted on the back face side of the gate heater is connected to a stem 8. The gate 2 is laid overlappedly on the seal plate 5 of the gate heater to be attached detachably with a bolt.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.04.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3406528

[Date of registration] 07.03.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-325313

(43)公開日 平成11年(1999)11月26日

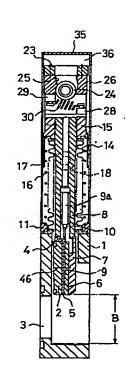
(51) Int.Cl.º	識別記号	FΙ	
F16K 49/00		F16K 49/00	В
3/16		3/16	
3/18		3/18	E
// C23C 16/44		C 2 3 C 16/44	В
HO1L 21/205		H 0 1 L 21/205	
		審查請求 有	請求項の数6 FD (全 12 頁)
(21)出願番号	特願平10-375581 (71)出願人 000232		2726
(62)分割の表示	特願平8-303679の分割	株式会	社ペンカン
(22)出願日	平成8年(1996)10月29日	東京都	队大田区山王2丁目5番13号
		(72)発明者 岩渕	俊昭
(31)優先権主張番号	特願平8-37471	群馬県新田郡薮塚本町大字六千石字東浦 5	
(32)優先日	平8 (1996) 1月31日	番地	株式会社ペンカン群馬製作所内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人 弁理士	三 三宅 景介
•			

(54) 【発明の名称】 半導体製造装置用無摺動ゲートパルプ

(57)【要約】

【課題】 ゲートをゲートヒーターにより加熱することができ、しかもゲートをゲートヒーターから分離することができるようにしてゲートの洗浄及び〇リングの交換を容易に行うことができるようにする。

【解決手段】 ゲートヒーターはホットプレート6の表面側にヒーター9を収め、シールプレート5をヒーター9のシール状態でホットプレート6の表面側に設ける。ゲートヒーターの背面側に取り付けたコネクター7をステム8に結合する。ゲートヒーターのシールプレート5上にゲート2を重ねてボルトにより取外し可能に取り付ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲートが流路口に対向する位置と離脱す る位置とに上下方向に移動され、前記ゲートが前記流路 口に対向した位置でほぼ水平方向に移動されて前記流路 口が開閉されるように構成された半導体製造装置用無摺 助ゲートバルブにおいて、ゲートの裏面側にこのゲート を加熱するためのゲートヒーターが配置され、前記ゲー トが前記ゲートヒーターに取外し可能に取り付けられた ととを特徴とする半導体製造装置用無摺動ゲートバル **ブ。**

【請求項2】 ベローズの外周にシーズヒーターが備え られたことを特徴とする請求項1記載の半導体製造装置 用無摺動ゲートバルブ。

【請求項3】 ゲートヒーターが、表面側に溝を有する ホットプレートと、前記溝に装着されたヒーターと、前 記ホットプレートの表面に前記ヒーターを被覆するよう に重ねられ、ゲートの裏面と接触状態に配置されるシー ルプレートとを備えたことを特徴とする請求項1または 2 記載の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ。

【請求項4】 ホットプレートとシールプレートとが全 20 周シール溶接されてヒーターが密閉されることを特徴と する請求項3記載の半導体製造装置用無摺動ゲートバル **ブ。**

【請求項5】 ゲートヒーターが、表面側に溝状の熱媒 流路を有するホットプレートと、このホットプレートの 表面に重ねられ、このホットプレートと全周シール溶接 されて前記熱媒流路を外部との間で熱媒が循環し得るよ うに密閉し、前記ゲートの裏面と接触状態に配置される シールプレートとを備えたことを特徴とする請求項1ま たは2記載の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ。

【請求項6】 ゲートがゲートヒーターのシールプレー ト上に重ねられ、前記ゲートが前記ゲートヒーターにと のゲートヒーターにおけるホットプレートの背面側から ボルト締めにより取外し可能に取付けられることを特徴 とする請求項1ないし5のいずれかに記載の半導体製造 装置用無摺助ゲートバルブ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造装置用 無摺動ゲートバルブに関する。

[0002]

【従来の技術】従来のゲートバルブは、図9に示すよう に流体流通路50の途中に直交して配設され、シリンダ ーに空気圧を供給することにより又はハンドル車を回転 することにより、アーム51に連結されているゲート押 し52とゲート53を移動し、開閉する。即ち、ゲート 53の閉め切りは、図9に示されるようにゲート53が ローラー54に接すると、カム55(又はリンク)によ り力の方向が変換されてゲート53にはめ込まれている

ート面58に押し付け、完全閉止状態とするものであ り、ゲート53の全開は、圧着されているゲート53を 一旦バルブシート面58から引き離し、その後アーム5 1を引き戻して図10に示すようにゲート押し52とゲ ート53を移動するものである。従って、〇リング56 はバルブシート面58に圧着されるのみで、全く摺動し ないとされている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このゲート 10 パルブは、ゲート53を閉じる助きを図11のa, bに 示すように台形状のカム55で作動させるが、開く動作 はスプリング59の引張力によるものであった。

【0004】そのため〇リング56が張り付いてしまう と、スプリング59の引張力ではゲート53が開かず、 ゲート53を引き上げる力で開くことになり、0リング 56がバルブシート面58をこすることとなる。また、 ゲート53の裏面から圧力が加わる逆圧状態でもスプリ ング59の引張力だけではゲート53を開くことができ ず、結局ゲート53を引き上げる力で開くことになり、 〇リング56がバルブシート面58をこすることにな る。

【0005】このように0リング56がパルブシート面 58をこすることは、パーティクルの発生が増大するの で、半導体製造装置においてはぜひとも回避しなければ ならない問題である。また、前記の無摺動ゲートバルブ の構造では、バルブの内側にカム55やローラー54な どの摺動部を有するので、発塵し易かった。さらに反応 ガスが触れる部位で使用される場合、ゲート53は、生 成物が付着しないようにヒーターにより加熱するように 30 するが、その場合、〇リング56が熱によりバルブシー ト面58に粘着し易くなり、ゲート53を開く時〇リン グ53のとすれ現象は免れることができなくなる。ま た、ゲートをヒーターにより加熱する場合、ヒーターを ゲートに内蔵させているため、ゲートの洗浄及び〇リン グの交換に不便であった。

【0006】そこで本発明は、ゲートをゲートヒーター により加熱することができ、しかも、ゲートをゲートヒ ーターから分離することができるようにしてゲートの洗 浄及び○リングの交換を容易に行うことができるように 40 した半導体製造装置用無摺動ゲートバルブを提供しよう とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に本発明の半導体製造装置用無摺助ゲートバルブは、ゲ ートが流路口に対向する位置と離脱する位置とに上下方 向に移動され、前記ゲートが前記流路口に対向した位置 でほぼ水平方向に移動されて前記流路口が開閉されるよ うに構成された半導体製造装置用無摺動ゲートバルブに おいて、ゲートの裏面側にとのゲートを加熱するための 〇リング56を、本体57の内壁に設けられたバルブシ 50 ゲートヒーターが配置され、前記ゲートが前記ゲートヒ

20

3

ーターに取外し可能に取付けられたことを特徴とするものである。

【0008】前記課題を解決するために本発明の他の半 導体製造装置用無摺動ゲートバルブは、前記構成におい て、ベローズの外周にシーズヒーターが備えられたこと を特徴とするものである。

【0009】そして、前記各構成において、ゲートヒーターとして、表面側に満を有するホットプレートと、前記溝に装着されたヒーターと、前記ホットプレートの表面に前記ヒーターを被覆するように重ねられ、ゲートの10 裏面と接触状態に配置されるシールプレートとを備えることができ、この場合、ホットプレートとシールプレートとを全周シール溶接して前記ヒーターを密閉するのが好ましい。

【0010】また、ゲートヒーターとして、表面側に満状の熱媒流路を有するホットプレートと、このホットプレートの表面に重ねられ、このホットプレートと全周シール溶接されて前記熱媒流路を外部との間で熱媒が循環し得るように密閉し、前記ゲートの裏面と接触状態に配置されるシールプレートとを備えることができる。

【0011】また、ゲートをゲートヒーターのシールプレート上に重ね、前記ゲートを前記ゲートヒーターにとのゲートヒーターにおけるホットプレートの背面側からボルト締めにより取外し可能に取付けることができる。【0012】前記のように構成された本発明によれば、ゲートをその裏面側のゲートヒーターにより加熱するので、ゲートに反応ガスによる生成物等が付着するのを防止することができる。そして、ゲートヒーターはゲートとは別に構成してゲートをゲートヒーターに取外し可能に取付けるようにしているので、保守等の際にはゲートを外すことができる。

【0013】また、ゲートヒーターを密閉構造に構成することにより、流路が大気圧から真空状態に変化しても ゲートヒーター内部はその影響を受けることがない。

【0014】また、ゲートをゲートヒーターにボルトで 結合することにより、ゲートの着脱を容易に行うことが できる。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブの実施形態を反応ガスが触れる部位で使用される無摺動ゲートバルブについて説明する。図1、図2において、1はボディ、2はボディ1の前面側に設けられた流路口3を開閉するゲートで、このゲート2の表面は上部が厚く下部が薄くなるように僅かにテーバが付され、表面周縁部にフッ素ゴム製Oリング4が備えられ、裏面側にゲートヒーターが内蔵されている。ゲートヒーターは、ゲート2の裏面にシールプレート5を介在して設けた同じ大きさのホットプレート6と、コネクター7を介してゲート2の上縁中央に接続されたステム8に内蔵せるシーズヒーター9及び熱電対10とよりな

る。ゲート2の上縁中央に接続されたステム8は、ボデ ィ1の上面に固設されたボンネット11の中央透孔12 の下縁周縁にフランジ13が固設されて立設されたベロ ーズ14に挿通の上、ベローズ14の上端に結合された ステムホルダー15に支持されている。ベローズ14は 外周側にシーズヒーター16及び熱電対17を備えてい る。ステムホルダー15の左右両側下部には支点ローラ -18が軸支されている。この左右の支点ローラー18 は夫々前記ボンネット11上の左右両側に立設されたシ リンダー19のハウジング20の外側面の垂直溝21に 上下助可能に嵌合されている。左右両側のシリンダー1 9のピストンロッド22の上端にはカムプレート23の 左右両端部が結合されている。カムプレート23の下側 には後述するカム用ローラー24を前後方向に移動させ るように図3に示すカム溝25を設けたローラーカム2 6が左右一対設けられている。この左右一対のローラー カム26のカム溝25に、前記カムプレート23の中央 部下側に上下動可能に配され前記ステム8の上端に結合 されたローラーホルダー27に保持せる左右一対のカム 用ローラー24が係合されている。前記ステムホルダー 15の左右両側上面の後端部にはスプリング用フック2 8が設けられ、前記ローラーカム26の左右両側下面の 前端部にはスプリング用フック29が設けられ、これら スプリング用フック28、29間に夫々前後方向に伸縮 するようにスプリング30が張設されている。

【0016】尚、31は左右両側のシリンダー19にワンタッチ継手32にて接続した流体供給管、33は流体流量を制御してシリンダー19の作動速度を調整するスピードコントローラ、34はサイドプレート、35はアッパープレート、36はカパープレート、37、38はゲートヒーター、ベローズヒーターの端子板、39はヒーターのコードで、ホルダー40に保持されている。【0017】前記シリンダー19の図1に示すストロークAは、ゲートの図2に示すストロークBにローラーカム26の図3に示す作動ストロークCを加えたもので、作助ストロークCは図3に示す水平方向の動きDに変換されるものである。

【0018】このように構成された実施形態の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブは、例えばCVD装置の反応がとロードロック室の仕切りに用いられ、無摺動ゲートバルブを閉じるには、左右両側のシリンダー19の上室にエアーを供給し、ビストンロッド22の上端に結合されたカムプレート23を図4、図5に示すように下降し、このカムプレート23と一体のローラーカム26を下降し、カム溝25に保持されたカム用ローラー24を介してローラーホルダー27を下降し、これに結合されたステム8を下降し、ステム8と一体のゲート2を下降する。ゲート2がボディ1の流路口3に対面するレベルまで下降すると、ベローズ14を圧縮して下降したステムホルダー15の左右両側下部に軸支された支点ローラ

-18がシリンダー19のハウジング20の外側面の垂 直溝21の下端で停止し、ステムホルダー15に保持さ れたステム8の下降も停止する結果、ゲート2はストロ ークBで下降が停止する。さらにシリンダー19の作動 によりカムプレート23が下降し、これと一体のローラ ーカム26が図3に示すストロークCだけ下降すると、 カム溝25によりカム用ローラー24を後方にDだけ水 平移助する結果、カム用ローラー24を保持せるローラ ーホルダー27が結合されたステムホルダー15はその 左右両側下部の支点ローラー18を支点にして図6に示 10 すように傾動し、ステム8が後方に傾いて表面にテーパ が付されたゲート2の表面が垂直となって流路口3を閉 じることになる。この時ゲート2の表面周縁部の〇リン グ4は流路口3の周縁部に密着し、確実にシールすると

【0019】次に無摺動ゲートバルブを開く場合につい て説明すると、左右両側のシリンダー19の下室にエア ーを供給し、ピストンロッド22の上端に結合されたカ ムプレート23を図4、図5に示すように上昇し、この - カムプレート23と一体のローラーカム26を図3に示 20 すストロークCだけ上昇すると、カム溝25に保持され たカム用ローラー24を前方にDだけ水平移動する結 果、カム用ローラー24を保持せるローラーホルダー2 7が結合されたステム8を保持せるステムホルダー15 はその左右両側下部の支点ローラー18を支点にして回 動し垂直に起立し、ステム8も垂直に起立してゲート2 が流路口3の周縁より離れる。さらに左右両側のシリン ダー19の作動によりカムプレート23を上昇し、カム プレート23と一体のローラーカム26を上昇すると、 カム溝25 に保持されたカム用ローラー24を介してロ 30 ーラーホルダー27が上昇し、これに結合されたステム 8を保持せるステムホルダー15がベローズ14を伸長 して上昇し、ステムホルダー15に保持されたステム8 と一体のゲート2が上昇する。ゲート2がボディ1の流 路口3を開放するレベルまでストロークBだけ上昇する と、シリンダー19のストロークがA=B+Cの上昇限 となり、ゲート2の上昇は停止する。

【0020】かかる無摺助ゲートバルブは、ゲート2を 裏面側のゲートヒーターのホットプレート6 により加熱 し、ゲート2や〇リング4にCVD装置の反応炉で生成 40 した反応生成物が付着しないようにする。また、ステム 8を上下勁するように挿通したベローズ14に反応生成 物が付着しないようにベローズ 1.4を外周側からシーズ ヒーター16により加熱する。その際、〇リング4はゲ ート2の加熱により粘着が生じても、ローラーカム26 のカム溝25とカム用ローラー24との係合によるカム **機構をシリンダー19の推力により強制的に動作させ** て、ゲート2を流体出入口3の軸線方向に水平に動かし て開くので、〇リング4は流路口3の周縁をこすること がなく、パーティクルの発生を抑制できる。また、ゲー 50 にホットプレート6′の背面からボルト46にて締め付

ト2の裏面から圧力が加わる逆圧状態でも、シリンダー 19の推力で強制的にカム機構を動作し、ゲート2を水 平に助かして開くので、0リング4は流路口3の周縁を こすることがなくパーティクルの発生を抑制できる。 【0021】上記実施形態の半導体製造装置用無摺助ゲ ートバルブに於けるゲートの裏面側に内蔵されているゲ ートヒーターは、ゲート2の裏面にシールプレート5を 介在して設けたホットプレート6と、コネクター7を介 してゲート2の上縁中央に接続されたステム8に内蔵せ るシーズヒーター9及び熱電対10とよりなるが、直接 加熱のホットプレート6が通路に露出している構造では 大気圧から真空への圧力変化によって温度が均一になら ないことがあり、また、ゲート2は脱着できないので、

洗浄及び〇リング4の交換ができない。

【0022】これを解決するため上記実施形態の半導体 製造装置用無摺動ゲートバルブに於いて、ゲート2の裏 面側に内蔵されるゲートヒーターの1つは、次のように 構成した。即ち、図7の(a)、(b)、(c)、 (d) に示すように軸中心部に透孔41を設けたステム 8′の下端部をホットプレート6′の上板中央に貫通の 上ホットプレート6′の上端中央に結合して、上板中央 の貫通部周縁をシール溶接した。また、ホットプレート 6′の表面周縁部に溝42を設けて、この溝42内にカ ートリッジヒーター43を装着し、そのカートリッジヒ ーター43の電線44をステム8′の軸中心部の透孔4 1を介して図1に示されるハウジング20の上側のサイ ドプレート34に取り付けられているゲートヒーターの 端子板37に接続した。そしてホットプレート6′の表 面にシールプレート5′を当てがい、その全周にシール 溶接45を施して、前記カートリッジヒーター43を密 閉した上、シールプレート5′の表面に同じ大きさのゲ ート2を脱着可能にホットプレート6′の背面からボル ト46にて締め付けて、ゲートヒーターを構成した。 【0023】さらにゲート2の裏面側に内蔵されるゲー トヒーターの他の1つを、図8の(a)、(b)、 (c)、(d)によって説明すると、ホットプレート 6′の表面周縁部に設けた溝42を熱媒流路となし、ス テム8′の軸中心部に設けた透孔41にステム8′の上 端より熱媒給排ブロック47の熱媒供給口47aに取り 付けた熱媒供給管48を挿通し、熱媒給排ブロック47 をステム8′の上端にねじにて固定し、熱媒供給管48 をし形の継手管49を介して前記熱媒流路42に接続 し、この熱媒供給管48の外周側を熱媒排出路48′と なすと共にこの熱媒排出路48′を前記熱媒給排ブロッ ク47の熱媒排出口47bを横向きに有する熱媒排出路 48 に接続した。そしてホットプレート6′の表面に シールプレート5′を当てがい、その全周にシール溶接

45を施して、前記熱媒流路42を密閉した上、シール

プレート5′の表面に同じ大きさのゲート2を脱着可能

けて、ゲートヒーターを構成した。

【0024】上記のように構成された2つのゲートヒーターは、カートリッジヒーター43や熱媒循環方式のヒーターをシールブレート5′にて完全密閉して備えたホットプレート6′よりなるので、ヒーターは流路に露出せず、従って大気圧から真空への圧力変化があってもホットプレート6′の温度は不均一となることがなく、ゲート2は均一に加熱させる。また、ゲート2がホットプレート6′に脱着可能にボルト46にて締め付けられているので、ゲート2の洗浄や0リング4の交換が容易に10できる。

[0025]

【発明の効果】以上要するに本発明の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブによれば、ゲートをその裏面側のゲートヒーターにより加熱するので、反応ガスが触れる部位、例えばCVD装置等の反応炉の仕切りに使用する場合、ゲートやシール用Oリングに反応生成物が付着するのを防止することができる。そして、ゲートヒーターはゲートとは別に構成してゲートをゲートヒーターと取外し可能に取付けているので、ゲートをゲートヒーターと 20分離することができてゲートの洗浄やOリングの交換を容易に行うことができる。

【0026】また、ゲートヒーターを密閉構造とすることにより、流路が大気圧から真空へ圧力変化してもゲートヒーターの内部は影響を受けないので、ゲートヒーターの温度は不均一になることがなく、ゲートを均一に加熱することができる。

【0027】また、ゲートをゲートヒーターにボルトにて結合することにより、着脱を容易に行うことができる

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブの実施例を示す開状態の縦断正面図である。

【図2】図1の1-1線縦断側面図である。

【図3】本発明の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ に於けるカム機構を示す縦断面図である。

【図4】図1の無摺動ゲートバルブの閉じるためにゲートを垂直に下降した状態を示す縦断面図である。

【図5】図4のII-II線縦断側面図である。

【図6】図5に示されたゲートを傾動して流路口を閉鎖 40 した状態を示す縦断側面図である。

【図7】ゲートの裏面側に内蔵される完全密封のゲート ヒーターの1つを示すもので、aはゲート取り付け前の 一部縦断正面図、bはa図のIII-III線縦断側面図、c はa図の側面図、dはゲートを取り付けた状態のa図の IV-IV線断面矢視図である。 【図8】ゲートの裏面側に内蔵される完全密封のゲート ヒーターの他の1つを示すもので、aはゲート取り付け 前の一部縦断正面図、bはa図のV-V線縦断側面図、 cはa図の側面図、dはゲートを取り付けた状態のa図 のVI-VI線断面矢視図である。

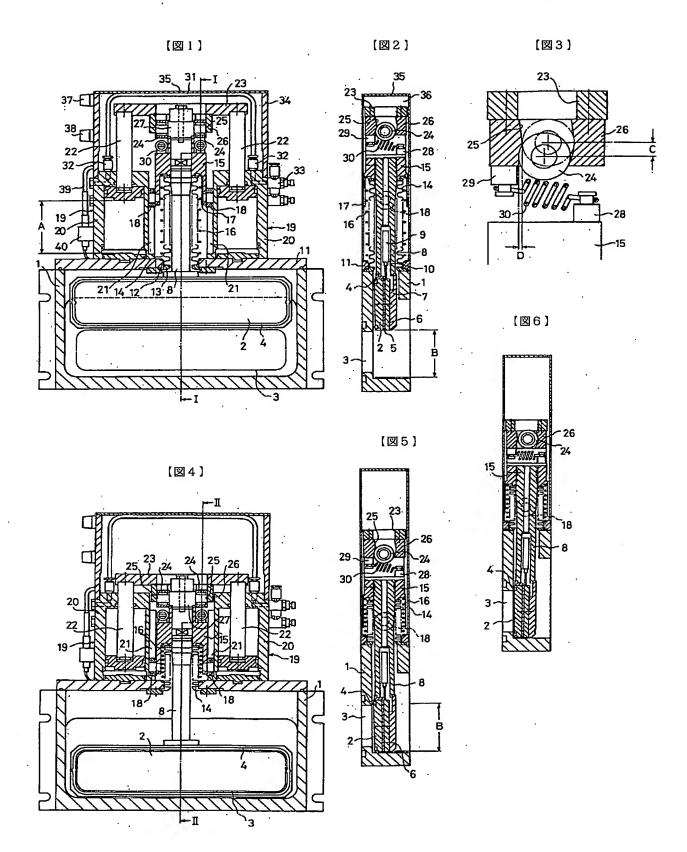
【図9】従来のゲートバルブの閉状態の縦断側面図であ る。

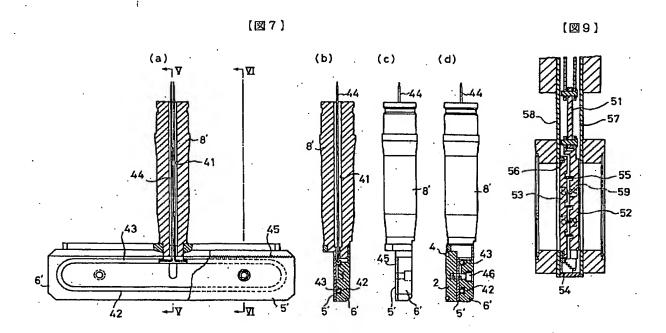
【図10】図9のゲートバルブの開状態の縦断側面図である。

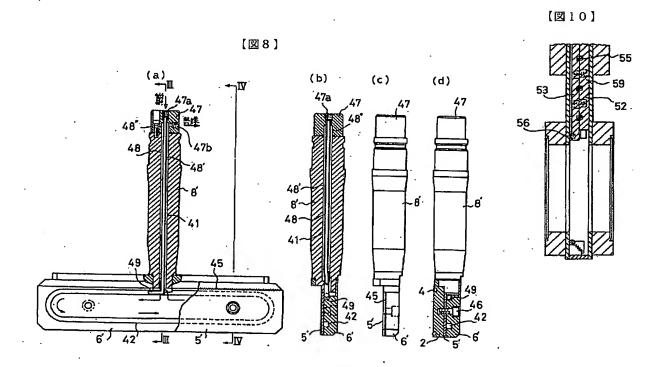
【図11】図9のゲートバルブにおけるゲートを閉じる カムを示す図で、a はゲートが開いている時、b はゲー トを閉じた時の状態である。

【符号の説明】

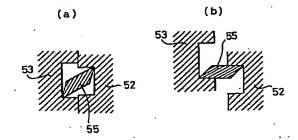
- 1 ボディ
- 2 ゲート
- 3 流路口
- 4 0リング
- 5,5'シールプレート
- 6.6' ホットプレート
- 7 コネクター・
 - 8.8' ステム
 - 9 シーズヒーター
 - 14 ベローズ
 - 15 ステムホルダー
 - 16 シーズヒーター
 - 18 支点ローラー
 - 19 シリンダー
 - 21 垂直溝
 - 22 ピストンロッド
- 30 23 カムプレート
- 24 カム用ローラー
 - 25 カム溝
 - 26 ローラーカム
 - 27 ローラーホルダー
 - 30 スプリング
 - 41 透孔
 - 42 溝状の熱媒流路
 - 43 カートリッジヒーター
 - 45 シール溶接
- 0 46 ボルト
 - 47 熱媒給排ブロック
 - 47a 熱媒供給口
 - 47b 熱媒排出口
 - 48 熱媒供給管
 - 48′ 熱媒排出路
 - 48″ 熱媒排出路







【図11】



【手続補正書】

【提出日】平成11年4月13日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲートが流路口に対向する位置と離脱する位置とに上下方向に移動され、前記ゲートが前記流路口に対向した位置でほぼ水平方向に移動されて前記流路口が開閉されるように構成された半導体製造装置用無摺動ゲートバルブにおいて、ゲートの裏面側にこのゲートを加熱するためのゲートヒーターが配置され、前記ゲートと前記ゲートヒーターとが取外し可能に取り付けられたことを特徴とする半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ。

【請求項2】 ベローズの外周にシーズヒーターが備えられたことを特徴とする請求項1記載の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ。

【請求項3】 ゲートヒーターが、表面側に溝を有するホットプレートと、前記溝に装着されたヒーターと、前記ホットプレートの表面に前記ヒーターを被覆するように重ねられ、ゲートの裏面と接触状態に配置されるシールプレートとを備えたことを特徴とする請求項1または2記載の半導体製造装置用無摺助ゲートバルブ。

【請求項4】 ホットプレートとシールプレートとが全 周シール溶接されてヒーターが密閉されることを特徴と する請求項3記載の半導体製造装置用無摺動ゲートバル ブ。

【請求項5】 ゲートヒーターが、表面側に満状の熱媒 流路を有するホットプレートと、このホットプレートの 表面に重ねられ、このホットプレートと全周シール溶接 されて前記熱媒流路を外部との間で熱媒が循環し得るよ うに密閉し、前記ゲートの裏面と接触状態に配置される シールプレートとを備えたことを特徴とする請求項1ま たは2記載の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ。

【請求項6】 ゲートがゲートヒーターのシールプレート上に重ねられ、前記ゲートが前記ゲートヒーターにとのゲートヒーターにおけるホットプレートの背面側からボルト締めにより取外し可能に取付けられることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造装置用 無摺助ゲートバルブに関する。

[0002]

【従来の技術】従来のゲートバルブは、図9に示すよう に流体流通路50の途中に直交して配設され、シリンダ ーに空気圧を供給することにより又はハンドル車を回転 することにより、アーム51に連結されているゲート押 し52とゲート53を移動し、開閉する。即ち、ゲート 53の閉め切りは、図9に示されるようにゲート53が ローラー54に接すると、カム55(又はリンク)によ り力の方向が変換されてゲート53にはめ込まれている 〇リング56を、本体57の内壁に設けられたバルブシ ート面58に押し付け、完全閉止状態とするものであ り、ゲート53の全開は、圧着されているゲート53を 一旦バルブシート面58から引き離し、その後アーム5 1を引き戻して図10に示すようにゲート押し52とゲ ート53を移動するものである。従って、Oリング56 はバルブシート面58に圧着されるのみで、全く摺動し ないとされている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このゲート パルブは、ゲート53を閉じる動きを図11の(a)、 (b)に示すように台形状のカム55で作動させるが、 開く動作はスプリング59の引張力によるものであっ た。

【0004】そのため〇リング56が張り付いてしまうと、スプリング59の引張力ではゲート53が開かず、ゲート53を引き上げる力で開くことになり、〇リング56がバルブシート面58をこすることとなる。また、ゲート53の裏面から圧力が加わる逆圧状態でもスプリング59の引張力だけではゲート53を開くことができず、結局ゲート53を引き上げる力で開くことになり、〇リング56がバルブシート面58をこすることになる

【0005】とのように〇リング56がバルブシート面58をとするとは、バーティクルの発生が増大するので、半導体製造装置においてはぜひとも回避しなければならない問題である。また、前記の無摺動ゲートバルブの構造では、バルブの内側にカム55やローラー54などの摺動部を有するので、発塵し易かった。さらに反反がガスが触れる部位で使用される場合、ゲート53は、生成物が付着しないようにヒーターにより加熱するようにするが、その場合、〇リング56が熱によりバルブシート面58に粘着し易くなり、ゲート53を開く時〇リング53のこすれ現象は免れることができなくなる。また、ゲートをヒーターにより加熱する場合、ヒーターをゲートに内蔵させているため、ゲートの洗浄及び〇リングの交換に不便であった。

【0006】そこで本発明は、ゲートをゲートヒーターにより加熱することができ、しかも、ゲートをゲートヒーターから分離することができるようにしてゲートの洗浄及び〇リングの交換を容易に行うことができるようにした半導体製造装置用無摺助ゲートバルブを提供しようとするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために本発明の半導体製造装置用無摺動ゲートバルブは、ゲートが流路口に対向する位置と離脱する位置とに上下方向に移動され、前記ゲートが前記流路口に対向した位置でほぼ水平方向に移動されて前記流路口が開閉されるように構成された半導体製造装置用無摺動ゲートバルブにおいて、ゲートの裏面側にこのゲートを加熱するためのゲートヒーターが配置され、前記ゲートと前記ゲートヒーターとが取外し可能に取付けられたことを特徴とするものである。

【 0 0 0 8 】前記課題を解決するために本発明の他の半 導体製造装置用無摺助ゲートバルブは、前記構成におい て、ベローズの外周にシーズヒーターが備えられたこと を特徴とするものである。

【0009】そして、前記各構成において、ゲートヒーターとして、表面側に溝を有するホットプレートと、前記溝に装着されたヒーターと、前記ホットプレートの表面に前記ヒーターを被覆するように重ねられ、ゲートの裏面と接触状態に配置されるシールプレートとを備える

ことができ、この場合、ホットプレートとシールプレートとを全周シール溶接して前記ヒーターを密閉するのが 好ましい。

【0010】また、ゲートヒーターとして、表面側に満状の熱媒流路を有するホットプレートと、このホットプレートの表面に重ねられ、このホットプレートと全周シール溶接されて前記熱媒流路を外部との間で熱媒が循環し得るように密閉し、前記ゲートの裏面と接触状態に配置されるシールプレートとを備えることができる。

【0011】また、ゲートをゲートヒーターのシールプレート上に重ね、前記ゲートを前記ゲートヒーターにとのゲートヒーターにおけるホットプレートの背面側からボルト締めにより取外し可能に取付けることができる。【0012】前記のように構成された本発明によれば、ゲートをその裏面側のゲートヒーターにより加熱するので、ゲートに反応ガスによる生成物等が付着するのを防止することができる。そして、ゲートヒーターはゲートとは別に構成してゲートをゲートヒーターに取外し可能に取付けるようにしているので、保守等の際にはゲートを外すことができる。

【0013】また、ゲートヒーターを密閉構造に構成することにより、流路が大気圧から真空状態に変化してもゲートヒーター内部はその影響を受けることがない。 【0014】また、ゲートをゲートヒーターにボルトで結合することにより、ゲートの着脱を容易に行うことが

[0015]

できる。

【発明の実施の形態】以下、本発明の半導体製造装置用 無摺動ゲートバルブを反応ガスが触れる部位で使用した 第1の実施形態について説明する。図1~図6におい て、1はボディ、2はボディ1の前面側に設けられた流 路口3を開閉するゲートで、このゲート2の表面は上部 が厚く、下部が薄くなるように僅かにテーパが付され、 表面周縁部に形成された溝にフッ素ゴム製〇リング4が 備えられ、裏面側にゲートヒーターが設けられている。 ゲートヒーターは、ホットプレート6とシールプレート 5の間にシーズヒータ9が内蔵され、ホットプレート6 及びシールプレート5はゲート2とほぼ同じ大きさに形 成されている。ゲート2の裏面がシールプレート5に重 ねられ、ホットプレート6の背面側からボルト46によ りゲート2が取外し可能に取付けられている。ゲートヒ ーターは、ホットプレート6の背面に取付けられたコネ クター7を介してステム8の下端部に接続されている。 ステム8の下端部内側の空所にはシーズヒーター9の外 部接続部9a及び温度調節用の熱電対10が収められて いる。

【0016】ボディ1の上面にボンネット11が固設され、ボンネット11の中央透孔12にステム8が挿通されている。ステム8の突出部外周にはベローズ14が設けられ、ベローズ14は中央透孔12の下縁周縁に固設

されたフランジ13とステム8の上端部外周に固設され た支持部材とに取付けられている。ベローズ14の外周 部にシーズヒーター16及び熱電対17が備えられてい る。ステム8の上端部にはステムホルダー15が取付け られ、ステムホルダー15の左右両側下部には支点ロー ラー18が回転可能に軸支されている。この左右の支点 ローラー18は夫々前記ポンネット11上の左右両側に 立設されたシリンダー19のハウジング20における外 側面の垂直溝21に上下助可能に嵌合されている。各シ リンダー19のピストンロッド22の上端にはカムプレ ート23の左右両端部が結合されている。 カムプレート 23の下側にはカム溝25を設けたローラーカム26が 左右一対設けられている。各ローラーカム26のカム溝 25に、ステム8の上端に結合されたローラーホルダー 27に保持せる左右一対のカム用ローラー24が係合さ れている。ステムホルダー15の左右両側上面の後端部 にはスプリング用フック28が設けられ、ローラーカム 26の左右両側下面の前端部にはスプリング用フック2 9が設けられ、これらスプリング用フック28、29間 に夫々前後方向に伸縮するようにスプリング30が張設 されている。

【0017】尚、図1中、31は左右両側のシリンダー19にワンタッチ継手32にて接続した流体供給管、33は流体流量を制御してシリンダー19の作助速度を調整するスピードコントローラ、34はサイドプレート、35はアッパープレート、36はカバープレート、37、38はゲートヒーター、ベローズヒーターの端子板、39はヒーターのコードで、ホルダー40に保持されている。

【0018】シリンダー19の図1に示すストロークAは、図2に示すゲート2のストロークBに図3に示すローラーカム26の作動ストロークCを加えたもので、作動ストロークCは図3に示す水平方向の動きDに変換されるものである。

【0019】このように構成された本実施形態の半導体 製造装置用無摺動ゲートバルブは、例えばCVD装置の 反応炉とロードロック室の仕切りに用いられ、無摺動ゲ ートバルブを閉じるには、左右両側のシリンダー19の 上室にエアーを供給することにより、図4、図5に示す ように、ピストンロッド22の上端に結合されたカムブ レート23、とのカムプレート23と一体のローラーカ ム26が下降する。これに伴い、ローラーカム26のカ ム溝25に保持されたカム用ローラー24を介してロー ラーホルダー27、これに結合されたステム8、ステム 8と一体のステムホルダー15、ゲート2等がベローズ 14を圧縮させて下降する。ゲート2がボディ1の流路 口3に対面するレベルまで下降すると、ステムホルダー 15の左右両側下部に軸支された支点ローラー18が垂 直溝21の下端で停止し、ステムホルダー15と一体の ステム8の下降も停止する結果、ゲート2はストローク

Bで下降が停止する。さらにシリンダー19の作助によりカムブレート23が下降し、これと一体のローラーカム26が図3に示すストロークCだけ下降すると、カム溝25中でカム用ローラー24が係合部25bから屈折部25aを逆傾斜面25c側に乗り越えさせられ、後方にりだけ水平移助する結果、カム用ローラー24を保持せるローラーホルダー27が結合されたステムホルダー15、ステム8及びゲート2はその左右両側下部の支点ローラー18を支点にして図6に示すように傾助し、表面にテーパが付されたゲート2の表面が垂直となって流路口3を閉じるととになる。この時、ゲート2の表面周縁部のOリング4は流路口3の周縁部に密着し、確実にシールすることになる。

【0020】次に無摺動ゲートバルブを開く場合につい て説明すると、左右両側のシリンダー19の下室にエア ーを供給し、ピストンロッド22の上端に結合されたカ ムプレート23を図4、図5に示すように上昇し、この カムプレート23と一体のローラーカム26を図3に示 すストロークCだけ上昇すると、カム溝25中でカム用 ローラー24が逆傾斜面25cから屈折部25aを係合 部25b側へ乗り越えさせられ、前方にDだけ水平移動 する結果、カム用ローラー24を保持せるローラーホル ダー27、ステムホルダー15、ステム8及びゲート2 等が支点ローラー18を支点にして回動して垂直に起立 し、ゲート2が流路口3の周縁より離れる。さらに左右 両側のシリンダー19の作動によりカムプレート23を 上昇し、カムプレート23と一体のローラーカム26を 上昇すると、カム溝25に保持されたカム用ローラー2 4を介してローラーホルダー27、ステムホルダー1 5、ステム8及びゲート2等がベローズ14を伸長して 上昇する。ゲート2がボディ1の流路口3を開放するレ ベルまでストロークBだけ上昇すると、シリンダー19 のストロークがA=B+Cの上昇限となり、ゲート2の 上昇は停止する。

【0021】かかる無摺動ゲートバルブは、ゲート2を 裏面側のゲートヒーターにおけるホットプレート6に収 めたシーズヒーター9によりシールプレート5を介して 加熱しているので、ゲート2やOリング4にCVD装置 の反応炉で生成した反応生成物が付着しないようにする ことができる。また、ステム8を上下助するように挿通 したベローズ14を外周側からシーズヒータ16により 加熱しているので、ベローズ14に反応生成物が付着し ないようにすることができる。また、ゲート2の加熱に より〇リング4の流路口3周囲に対する粘着性が生じて も、ローラーカム26のカム溝25とカム用ローラー2 4との係合によるカム機構をシリンダー19の推力によ り強制的に助作させて、ゲート2を流路口3の軸線方向 に沿うように水平方向に移動させて開くので、Oリング 4は流路口3の周縁をこすることがなく、パーティクル の発生を抑制できる。また、ゲート2の裏面から圧力が

加わる逆圧状態でも、シリンダー19の推力で強制的に カム機構を動作し、ゲート2を水平に動かして開くの で、Oリング4は流路口3の周縁をこすることがなく、 パーティクルの発生を抑制できる。

【0022】次に、本発明の第2の実施形態について図 7 (a)~(d)を参照しながら説明する。本実施形態 に係る半導体製造装置用無摺動ゲートバルブは、上記第 1の実施形態に係る半導体製造装置用無摺動ゲートバル ブとはゲートヒータの様成を異にするので、このゲート ヒーターの構成について説明し、その他の構成について はその説明を省略する。図7(a)、(b)、(c)、 (d) に示すように、軸中心部に透孔41を設けたステ ム8′の下端部がホットプレート6′の上板中央に貫通 されてホットプレート6′の上端中央に結合され、上板 中央の貫通部周縁とステム8′とがシール溶接されてい る。ホットプレート6′のゲート2側の表面周縁部に溝 42が形成され、この溝42内にカートリッジヒーター 43が収められ、そのカートリッジヒーター43の電線 44がステム8′の軸中心部の透孔41に通され、図1 に示されるハウジング20の上側のサイドプレート34 に取り付けられている端子板37に接続されている。ホ ットプレート6′の表面にシールプレート5′が当てが われ、それらの全周にシール溶接45が施されてカート リッジヒーター43が密閉されている。そして、ゲート ヒーターのシールプレート5%の表面に同じ大きさのゲ ート2が重ねられ、ホットプレート6′の背面からボル ト46にてゲート2が締め付けられてゲート2がゲート ヒーターに取外し可能に取付けられている。

【0023】次に、本発明の第3の実施形態について図 8 (a)~(d)を参照しながら説明する。本実施形態 に係る半導体製造装置用無摺動ゲートバルブは上記第1 の実施形態に係る半導体製造装置用無摺動ゲートバルブ とはゲートヒーターの構成を異にするので、このゲート ヒーターの構成について説明し、その他の構成について はその説明を省略する。図8(a)、(b)、(c)、 (d) に示すように、ホットプレート6′のゲート2側 の表面周縁部に溝状の熱媒流路42が形成されている。 ステム8′の軸中心部に設けた透孔41に熱媒供給管4 8が挿通され、熱媒供給管48の一端がステム8′の上 端にねじにより固定した熱媒給排ブロック47の熱媒供 給□47aに接続され、熱媒供給管48の他端がL形の 継手管49を介して熱媒流路42に接続されている。熱 媒供給管48の外周の熱媒排出路48′が熱媒給排ブロ ック47における熱媒排出口47bを横向きに有する熱 媒排出路48"に接続されている。ホットプレート6' の表面にシールプレート5′が当てがわれ、それらの全 周にシール溶接45が施されて熱媒流路42が密閉され ている。そして、ゲートヒーターのシールプレート5′ の表面に同じ大きさのゲート2が重ねられ、ホットプレ ート6′の背面からボルト46にてゲート2が締め付け

られてゲート2がゲートヒーターに取外し可能に取付け られている。

【0024】上記第2、第3の実施形態に係るゲートバルブのゲートヒーターでは、カートリッジヒーター43や熱媒循環方式のヒーターを収めたホットブレート6′をシールブレート5′にて完全密閉しているので、大気圧から真空への圧力変化があっても温度が不均一となることがなく、ゲート2の全体を均一に加熱することができる。また、ゲート2がゲートヒーターに着脱可能にボルト46にて締め付けられているので、ゲート2の洗浄やOリング4の交換を容易に行うことができる。

[0025]

【発明の効果】以上要するに本発明の半導体製造装置用無摺助ゲートバルブによれば、ゲートをその裏面側のゲートヒーターにより加熱するので、反応ガスが触れる部位、例えばCVD装置等の反応炉の仕切りに使用する場合、ゲートやシール用Oリングに反応生成物が付着するのを防止することができる。そして、ゲートヒーターはゲートとは別に構成してゲートとゲートヒーターとを取外し可能に取付けているので、ゲートをゲートヒーターと分離することができてゲートの洗浄やOリングの交換を容易に行うことができる。

【0026】また、ゲートヒーターを密閉構造とすることにより、流路が大気圧から真空へ圧力変化してもゲートヒーターの内部は影響を受けないので、ゲートと均一に加熱することができる。

【0027】また、ゲートをゲートヒーターにボルトに て結合することにより、着脱を容易に行うことができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る半導体製造装置 用無摺助ゲートバルブを示す開状態の縦断正面図であ る。

【図2】同半導体製造装置用無摺動ゲートバルブを示し、図1のI-I線縦断側面図である。

【図3】同半導体製造装置用無摺動ゲートバルブに於けるカム機構を示す縦断面図である。

【図4】同半導体製造装置用無摺動ゲートバルブを示し、閉じるためにゲートを垂直に下降した状態を示す縦 断面図である。

【図5】同半導体製造装置用無摺動ゲートバルブを示し、図4のII-II線縦断側面図である。

【図6】同半導体製造装置用無摺動ゲートバルブを示し、ゲートにより流路口を閉鎖した状態を示す縦断側面図である。

【図7】(a)~(d)は本発明の第2の実施形態に係る半導体製造装置用無摺助ゲートバルブに於けるゲートヒーターを示し、(a)はゲート取り付け前の一部縦断正面図、(b)は(a)のIII-III線縦断側面図、

(c)は(a)の側面図、(d)はゲートを取り付けた 状態の(a)のIV-IV線断面矢視図である。

【図8】(a)~(d)は本発明の第3の実施形態に係る半導体製造装置用無摺動ゲートバルブに於けるゲートヒーターを示し、(a)はゲート取り付け前の一部縦断正面図、(b)は(a)のV-V線縦断側面図、(c)は(a)の側面図、(d)はゲートを取り付けた状態の(a)のVI-VI線断面矢視図である。

【図9】従来の半導体製造装置用無摺助ゲートバルブを 示し、閉状態の縦断側面図である。

【図10】同ゲートバルブを示し、開状態の縦断側面図である。

【図11】(a)、(b)は同ゲートバルブにおけるゲートを閉じるカムを示し、(a)はゲートが開いている時、(b)はゲートを閉じた時の状態を示す図である。 【符号の説明】

- 1 ボディ
- 2 ゲート
- 3 流路口
- 4 0リング
- 5.5' シールプレート
- 6,6' ホットプレート
- 7 コネクター・
- 8.8' ステム
- 9 シーズヒーター
- 14 ベローズ
- 15 ステムホルダー
- 16 シーズヒーター
- 18 支点ローラー
- 19 シリンダー
- 21 垂直溝
- 22 ピストンロッド
- 23 カムプレート
- 24 カム用ローラー
- 25 カム溝
- 26 ローラーカム
- 27 ローラーホルダー
- 30 スプリング
- 41 透孔
- 42 溝状の熱媒流路
- 43 カートリッジヒーター
- 45 シール溶接
- 46 ボルト
- 47 熱媒給排ブロック
- 47a 熟媒供給口
- 47b 熱媒排出口
- 48 熱媒供給管

48′ 熱媒排出路 48″ 熱媒排出路

【手続補正2】

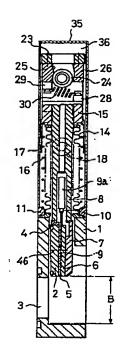
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

【図2】



【手続補正3】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図3 【補正方法】変更 【補正内容】 【図3】

